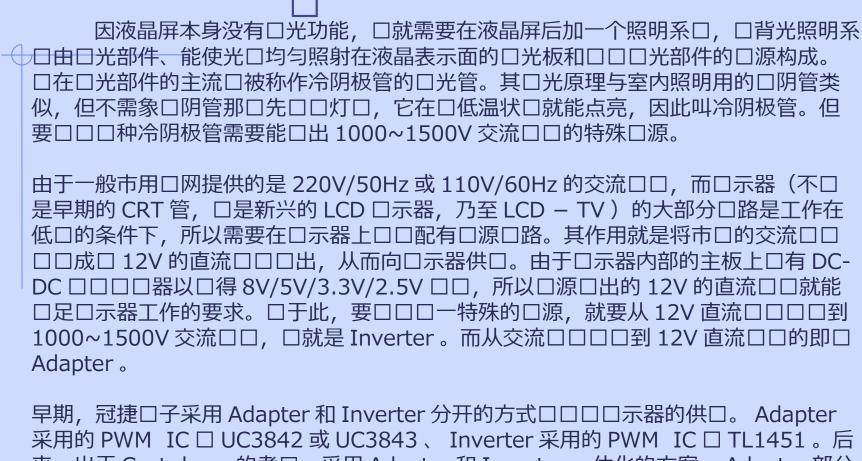
TV □源原理

品□工程部

林□恩

FEB-22-05

LCD TV □源介



采用的 PWM IC UC3842 或 UC3843、 Inverter 采用的 PWM IC TL1451。后来, 出于 Cost down 的考口, 采用 Adapter 和 Inverter 一体化的方案, Adapter 部分采用的 PWM IC SG6841、 Inverter 部分采用的 PWM IC TL1451。随着灯管的增加及所需的功率不断增加, Inverter 部分回路的口口方案得到口口,由原来的 Royer 回路口口全口式回路,口此口用到 OZ960IC。

第一□、开关□源的基本工作原理

开关□源是利用□□比率控制(Time Ratio Control, □写□ TRC)的方法来控制□□□□出的。按 TRC 控制原理,有以下三种方式:

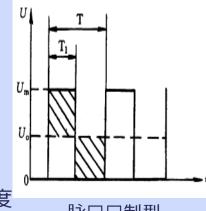
- 1)脉冲□度□制(Pulse Width Modulation, □写□ PWM)。开关周期恒定, 通□改□脉冲□度来 改□占空比的方式。
 - 2)脉冲口率口制(Pulse Frequency Modulation, 口写口 PFM)口通脉冲口度

恒定,通口改口开关工作口率来改口占空比的方式。

- 3)混合□制□通脉冲□度和开关工作□率均不固定,彼此都能改□的方式,
- 它是以上二种方式的混合。

│ 在目前开□和使用的开关□源集成□路中,□大多数也□脉□□ 制型。本□□采用的就是脉□□制型(PWM)开关□□□源,其 基本原理可参□右□。

□于□极性矩形脉冲来□,其直流平均□□ Uo 取决于矩形脉冲的□度,脉冲越□,其直流平均□□□就越高。直流平均□□ Uo 可由公式□算,即



脉□□制型

Uo=Um×T1/T

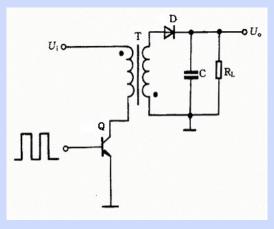
式中 Um — 矩形脉冲最大口口口;

T — 矩形脉冲周期;

T1 — 矩形的以唇出,当 Um 与 T 不□□,直流平均□□ Uo 将与脉冲□度 T1 成正比。□□,只要我□□法使脉冲□度随□□□源□出□□的增高而□窄,就可以达到□定□□的目的。

	此外, □因□各种不同的□出功率, 开关□源按 DC/DC □□器的工作方式分又可分
	□反激式(Flyback)、□向式(Forward)、全□式(Full Bridge)、半□式
	(Half Bridge)和推挽式(Push-Pull)等口路拓扑(Topology)口构。其中口端反
(激式开关口源是一种成本最低的口源口路,口出功率口 $20 \sim 100 \text{ W}$,可以同口口出
	不同的□□,且有□好的□□□整率,□用□□广泛其典型的□路如□所示。

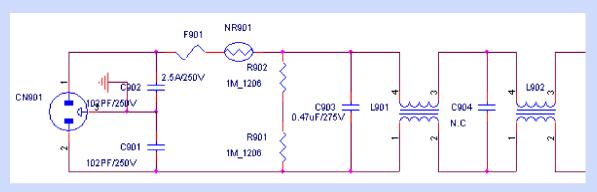
藉由 PWM IC 控制开关管的□通与否,配合次□□的□极管和□容,即可得到□定 DC □□的□出。Ui □含有一定交流成份的直流□□,由开关功率管□波和高□□□器降□,将□存于在□□器的能量□□□次□□,□□成所需□□□的方波,最后再将□个方波□□□整流□波□□所需要的直流□□。此外改□□□器初、次□的圈数,就可以得到想要的DC □源。PWM 控制□路是□类开关□源的核心,它通□取□反□□□□路,□整高□开关元件的开关□□比例即占空比,以达到□定□出□□的目的。



□ 1-1 反激式开关□源典型□路□构

由于高□□□器的磁芯只有一个□出端,而 MOS 开关功率管□通□,次□整流二极管截止,□能就□存在高□□□器的初□□感□圈中;当 MOS 功率管关断□整流二极管□通,初□□圈上的□能□□□次极□□,并□□次□整流二极管□出,故称之□□端反激式。

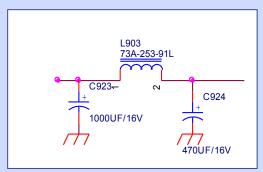
第一□ 开关□源的干□特性及其抑制措施



□□波器是一典型的低通□波器,使开关□源□生的一些高□脉冲干□□□它后得到极大的衰减,能□好的□除来源于□网或者□入□网的干□,使其符合 FCC 、 CE 、 VDE 等□准。□中 L901 、 L902 □共模扼流圈,它是□在同一磁□上的两只独立的□圈,圈数相同,□向相反,在磁□中□生的磁通相互抵消,磁芯不会□和,主要抑制共模干□,感□愈大□低□干□即制效果愈佳。□□□制的□波□感抑制共模干□的性能大大提高。 L901 、 L902 分别□□感□□ 2.0mH 和 15mH 的共模扼流圈。			
C901、C902 □共模□容,主要抑制差模干□,即火□和零□分别与地之□的干□。□容□			
愈大□低□干□抑制效果愈好,在□里□用 102PF/250V。 C903、 C904 □差模□容,主要抑制共模干□,即抑制火□和零□之□的干□。□容□愈大□低□干□抑制效果愈佳,在□里□用 0.47uF/300V。有□□了降低成本也可将 C904 省去。□中 CN901 □插座,接□网□□。 F901 □保□□,□路中采用了□格□ 2A/250V 的保□□,它在高□□熔断,可防止□□在突□的高□□引起的破坏。 NR901 □□温度系数□敏□阻,开机瞬□温度低,阻抗大,防止□流□回路的浪涌冲□。常温下其□格□ 5A/5Ω。 R901、R902 □抗干□□容起泄放作用,可于关机后迅速消耗掉 C903 □存的□能,防止□□□耗元件。它□的□格都□ 1MΩ,一般采用金属釉材料。			
□出端的干□抑制,主要也是靠高□□波器,□路□如下所示:			

□波□感由于工作在直流大□流状□下,磁芯在□大的磁□ 强度下工作,容易包含,一旦□和,□感即失去□波作用。因此 必□采用□和磁□强度很大的恒 μ 磁心,如□□□磁粉芯等金属 磁芯。[2]

由于口出干口的口口相当丰富,从几十赫兹到几十兆赫兹均含分量。由于在高口的情况下,口波口容等效由口口容(C)、等效串口口阻(RES)和等效串口口感(LES)构成的串口口路。在工作口率 f 超口口容器的自口振口率 fr 口,口容器就起到口感的作用。



□ 1-2 □出端抑制□□干□□路

□大的□波□容□低□干□比□敏感,相反,□小的□波□容吸收高□干□的效果比□好。因此不能光采用大□解□容□波 C923 ,□必□加接自□振□率很高的□容器 C924。
此外,口出干口的幅度口与 PCB 板的布口有很大关系,不合理的布口往往会使干口幅度大几倍,尤其是接地点的安排特别重要。 1.2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

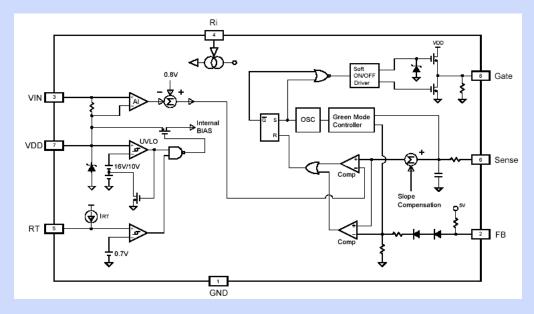
第二□ 脉□□制控制器 SG6841

2.1 PWM 控制器 SG6841 □介

目前,开关口源的集成化与小型化已成口口口,早期的 PWM IC 大多采用 UC384X 系列(如
UC3842 、UC3843),但由于新□品越来越□体化及□保和安□要求越来越□苛的□□下,
出口了 384XG 及 684X 等具有 Green Function 的 IC 。 Green Function □□保功能的意思,
亦称之□ Blue Angel, 其要求是在□□ 70W 以下的□源□品, 当□□没有□出功率的情况〕
,□入□源仍照常供□□,□路消耗功率必需小于 1W 以下。 SG6841 是由 System Genera
崇□科技开□的一款高性能固定□率□流模式控制器,□□离□和 DC - DC □□器□用而□
□。它属于□流型□端 PWM □制器,具有管脚数量少、外□□路□□、安装□□□便、性能
□良、价格低廉等□点,可精确地控制占空比,□□□□□□出,□□有低待机功耗和众多保□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
功能,所以,□□□人□提供只需最少的外部元件就能□得成本效益高的解决方案,在□□□
得到广泛的口用。 SG6841 有下列性能特点:
特到 龙町山用。 3G0041 有下列住配付点:
在无口口和低口口口口, PWM 的口率会口性降低口入待机模式以口口低功耗, 同口提供口
· 勺口出□□。
由于采用 BiCMOS , 启□□流和正常工作□流减少到 30μA 和 3mA ,因此可大大提高□源的
]效率。
SG6841 是固定□率的 PWM 控制器,它的工作□率通□一个外接□阻来决定,改□□阻□可
B改□□率。
内建同步斜率□□□路,可保□□□工作模式下□流回路的□定性。
内建口口口口口路可在一个口大的 AC 口入范口内口口功率限制控制,并提供口口、短路保口
论。此外,□□有低□□□定(UVLO)功能,使工作更□定、可靠。
可通□外接一个□温度系数□敏□阻(NTCR)来□感□境温度以□□□温保□,也可利用
具有□□柱(即推拉□出□路)□出极,可□□良好的 EMI 。其最大□出□□□位在 18V 。

常□的 SG6841 有 8 脚 DIP 和 SO 两种封装,其各引脚功能分别如下所示:		
GND : 接地。		
FB :反□□□□入端。用于提供 PWM □□信息, PWM 占空比就是由它控制。		
Vin :启□□流□入端。 SG6841 开始工作必□在□端要提供一个启□□□。		
→RI:参考□置端。通□□接一个□阻接地来□SG6841提供一个恒定的□流,改□□阻		
阻口将改口 PWM 的口率。		
RT:温度保□端。□端□出一个恒定的□流。在□端接一 NTCR 接地来□感温度,当□		
端□□下降到一定□□会启□□温保□。在本□□中,□功能被用于高□保□。		
Sense :□流□感端。当□端□□达到一个□□□芯片会停止□出,从而□□□流保□。		
VDD :□源供□端。		
Gate: PWM 脉冲□出端。□□柱(即推拉□出□路)□出极□□功率开关管。		

2.2 SG6841 内部□构与工作原理



□ 2-1 SG6841 内部框□

2)	欠□	□定
/		

SG6841 采用了欠□□定比□器来保□□出□被□□之前,集成□路已完全可用。欠□□定回路其□□是一个滞回比□器,以防止在通□它□各自的□限□□生□□的□出□作。它的开启□□□ 16V,关□□□□ 10V。在启□□程中,比□器反向□入端□ 16V,当 VDD□16V□,比□器□出□低□平,SG6841 无法工作。当 VDD 升到 16V□,欠□□定器□出□高□平,SG6841 正常工作,同□ MOS 管□通,使比□器反向□入端□ 10V。当 VDD 下降至10V□,欠□□定器的□出回到低□平,整个□路停止工作。SG6841 的 7 脚端□置了一个32V的□□□无极管,保□内部□路□□工作在 32V 以下,以防□□□高□坏芯片。

3) □出部分

SG6841 的 8 脚□□出脚,它是一个□□滕柱□出□,□□□□用来直接□□功率 MOSFET 的,具有降低□□耗、提高效率和增强可靠性的作用。在芯片内部有一 18V 的□□管与 Gate 端相□使□出□□□位在 18V ,可保□ MOSFET 免被□穿。通□控制 PWM 脉冲的上升与下降□□,可有效减少开关噪声,提高□源的 EMI ,并提供□定的 MOSFET 管 Gate 极□□。在 1.0nF □□□,它能提供高达 ±1.0A 的峰□□□□流和典型□□ 250ns 的上升□□和 50ns 的下降□□。□附加了一个内部□路,使得任何□候只要欠□□定有效,□出就□入灌模式,□个特性使外部下拉□阻不再需要。

4)□流取□比□器和脉冲□制□存器

SG6841作□□流模式控制器工作,□出开关□通由振□器开始振□起始,当峰□□感□流到达 FB 反□端□平□□止。□□在逐周基□上□差信号控制峰□□感□流。所用的□流取□比□器 - 脉□□制□存配置确保在任何一定的振□周期内,□有一个□脉冲出□在□出端。

□感□流通□插入一个与□出开关 Q901 的源极串□的以地□参考的取□□阻 Rs □□成□□。此□□由□流取□□入端 Pin6 Sense □□,并与来自 Pin2 FB 端□平相比□。通常取□□阻 Rs □一小□阻。在正常的工作条件下,峰□□感□流由管脚 1 上的□□控制,其中: Ipk = (VFB – 1.0V) /3RS

其中, VFB □ FB 端□□, 1.0V □在两个二极管上的□降, 1/3 □□两个□阻后的分□
比。
当□源□出□□或者如果□出□□取□□失□,异常的工作条件将出□。在□些条件下,□
流取□比□器□限将被内部箝位至 0.85V。因此最大峰□开关□流□:
lpk (max) =0.85V / Rs 当□入□□很大□,取□□流将非常小,□□可通□高□□□回
路来巴口口短路或其它原因引起功率管05流增加,1种使取提高阻免sel端口产升高。高于Sense
蹋的□□达到 0.85V □, RS 触□器的 R 端□入□低□平,从而 Q 非□出低□平, SG6841
即停止脉冲口出,可以有效的保口功率管不受口坏,从而口口口流保口。由此可得
lpk (max) = 0.85V/Rs ,改□ Rs □即可改□其最大的□出功率。在本□□中取 Rs =
0 _. 3Ω,可得 lpk (max)= 2.83A 。
在 SG6841 的 Sense 端口生的噪声会引起 PWM 口出脉冲的不口定。在芯片内部 Sense
端口口一个斜率口口口路后,才接至比口器同相口入端,口能有效地降低噪声的影响。良好的
PCB 布□和避免元件管脚太□也有利于减少噪声。而在 UC3841 的□用□路中□需要在
Sense 端增加一个 RC □波器来解决同□的□□,可□ SG6841 的功能更强,外□□路更□
当 SG6841 正常工作口,其内部振口器口生振口信号,此信号一路直接加到口口柱口路的
□入端,另一路加到 PWM 脉□□制 RS 触□器的 S 端, RS 型 PWM 脉□□制器的 R 端接□
流口口比口器口出端。当峰口口感口流未达到 FB 反口端口平口,比口器口出低口平,此口 R
端口低口平, Q 非端口出低口平;当峰口口感口流达到 FB 反口端口平口,比口器口出高口平
,此□ R 端□高□平, Q 非端□出高□平。可□, FB 端□□越高, Q 非端脉冲越□,同□
Gate 端□出脉□也越□(占空比增大);FB 端□□越低,Q 非端脉冲越窄,同□ Gate 端
☑ 治 膝 G 格 移 育 唐 卣 客 横 □ 小),从而 □ □ P W M 控制,使 □ 出 □ □ □ 定。
SG6841 需要在启□□□ Pin3 Vin 提供一 30µA 的启□□流以使芯片□行有效的自□。
在□路中,将 Pin3 通□两个 1MΩ 的□阻接至 PFC □的 DC □出端,便可在 AC □入 90V
~ 264V 的范□内□□ SG6841 的有效启□。
在 SG6841 正常工作后,其 Pin7 VDD 端必□提供 10V ~ 30V □□□芯片供□。

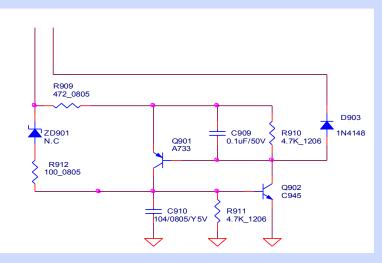
2.4 高□保□□路

SG6841 的 Pin5 RT 端恒定□出一□流 IRT : IRT =

 $\square \square \square \square \square NTCR \square \square \square \square R_{NTC} \square I_{RT} \times R_{NTC} < 0.65 V \square$

 $0.65V \square \square PWM$

高□保□回路如□ 2-2 所示。当□网□□升高 超□最大□□,自□□圈□出的□□也将升高。若 □□超□ 20V , 此□ ZD901 被□穿, R912 就会 □生□降。当□个□降有 0.6V □将使 Q902 □通 拉低 Q901 的基极□位,使 Q901 也□通,□□ SG6841 Pin5 通□ D903 、 Q903 直接接地,使 SG6841 迅速关断脉冲□出。同□ Q901 的□通也 拉低了□入到 SG6841 Pin7 的□□, 使 SG6841

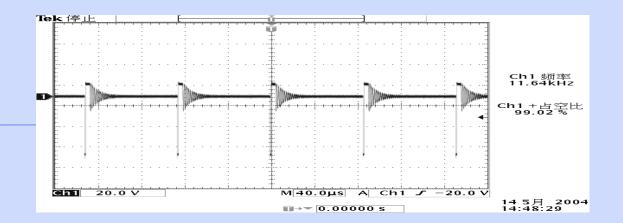


高□保□回路部分□路□ \square 2-2

停止工作。 **2.5 待机工作模式**

SG6841 具有 Green Function, 支持 Blue Angel 模式。当低口口和无口口情况下, FB 端□□会有所降低□,当其低于一个□□□□□,会□入□能模式, SG6841 的 PWM 工作□率会迅速降低至 10kHz 左右,此□仍有□定的 12V □□□出。如□所示 即□待机□功率开关管 D 极的□□波形。

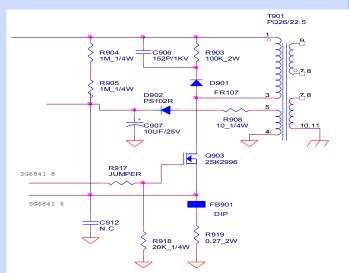
 $SG6841 \square PWM \square$ 12V □



□ 2-13 待机模式功率开关管 D 极的□□波形

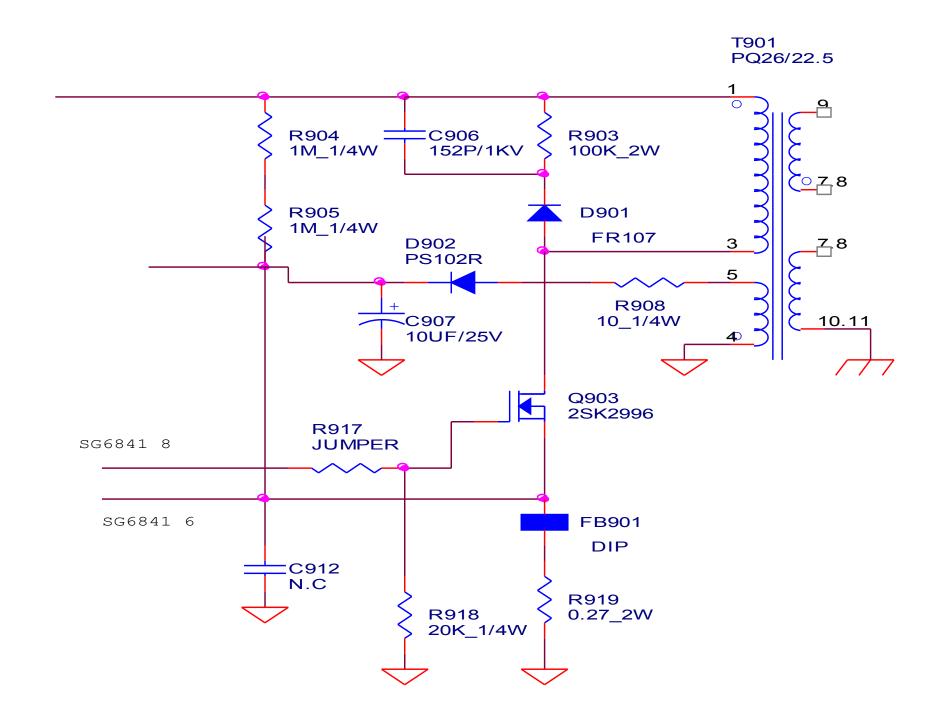


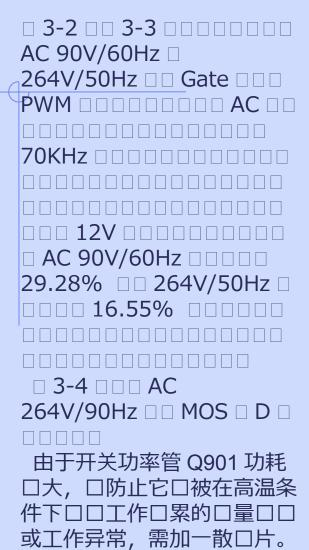
第三□ 直流□□□路及工作□程

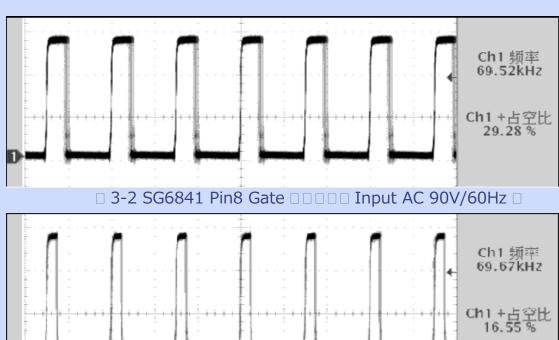


□ 3-1 直流□□□路

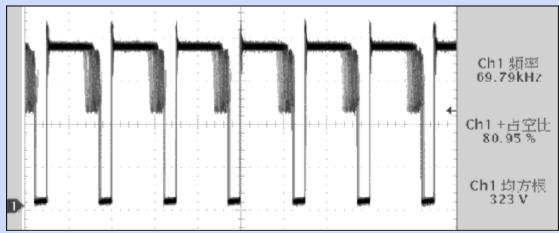
由于在开关管关断口,初口口圈口有口流,因此口防止随开关启 - 口所口生的口口浪涌,可采用 R-C 或 L-C 口冲器。本口口中在口口器的口入端需口有口冲口路,它由 D901 、 R903 与 C906 口成。在开关管关断的瞬口,口感上的口流通口 D901 向 C906 充口;口了确保在开关管截止期口,不能因口 C906 的充口而减小口芯向口口口放的能量,即充口口口口小于 Toff ;另外,口了避免在开关管在关断的口程中工作在高口口大口流区,充口口口口大于或等于 Toff 。因此口合考口上述两方面的因素,口取 C906 的充口口口等于 Toff 。因此取 C906 的口口 152pF,它的耐口口口 1KV。在开关管口通的瞬口,口容 C906 通口 R 与开关管放口,放口的口口常数 r=RC906,口了减口开关管在完全口通口所承受的口流,口在开关管开启的口口 Ton 内放掉 C906 上的大部分能

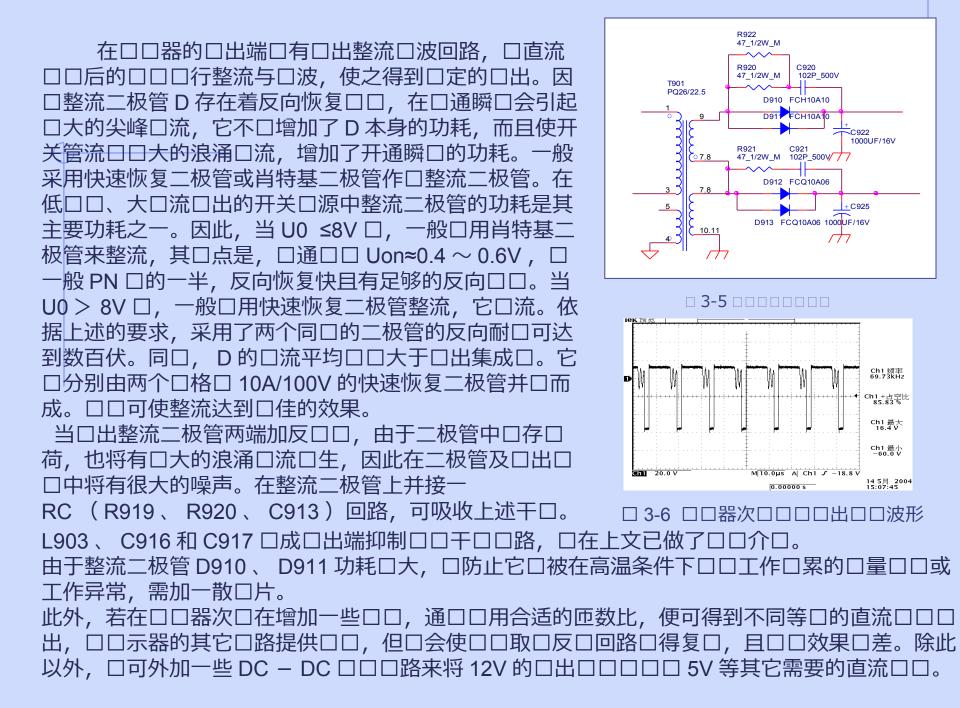






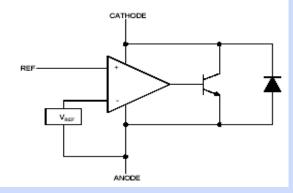






第四□ □□取□和反□回路

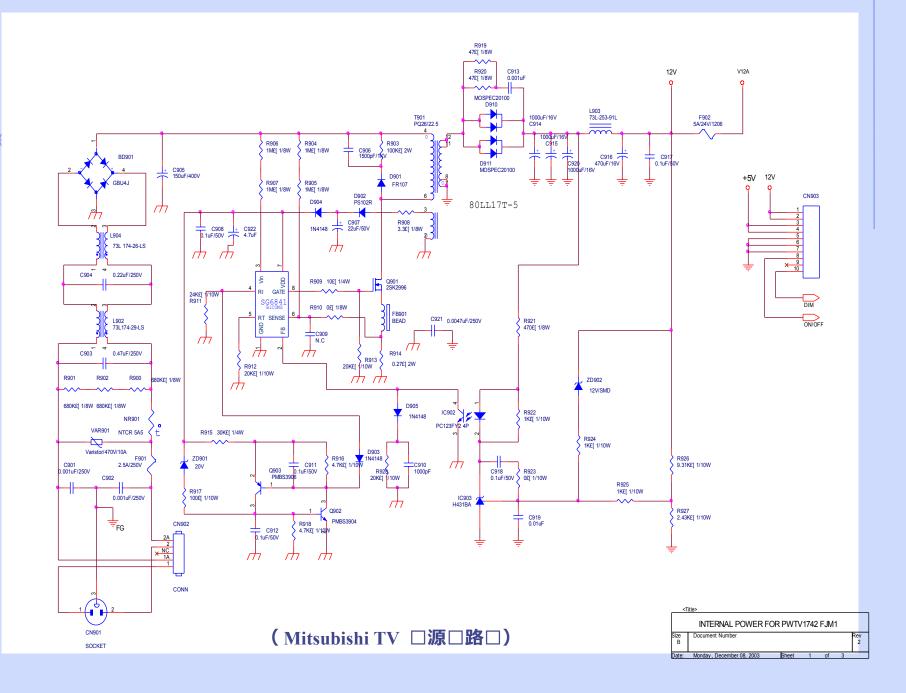
- ____ Anode _



□ 4-1 TL431 内部原理□

□□□出端 12V □□由 R925 和 R926 分□后□入 TL431 的 REF 端,其中 R925 的阻□□ 4.3K , R926 的阻□□ 2.4K 。当□源正常工作□,□出 5V 的□□□分□后□好□ 2.5V □入 TL431 。

- 0000 R936 0 C929 000000000000000000

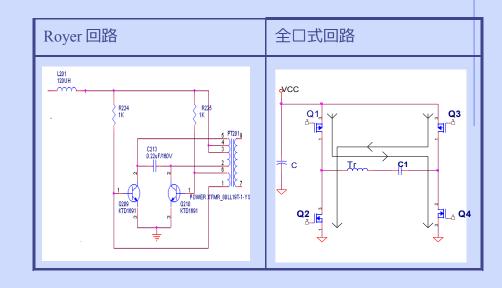


第二章 Inverter 原理

以前,我口公司的 INVERTER 口口大部分口是采用口口的 Royer 回路,而 Mitsubishi TV 口采用一种全口式的口路。

下面我来□□地介□一下 Royer 回路与 全□式回路的不同工作原理:

Royer 回路是根据通□启□□阻 R224/R225 提供开关晶体管的基极□流使 其通、断工作,并利用□□器的□和特性, 要求采用矩形磁滞回□的□芯,□种□□器 的□路□构□□,

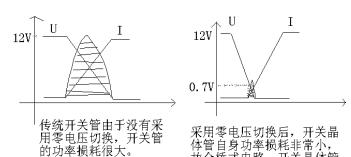


使用 \square 口芯 \square 和,不 \square 口芯 \square 耗大,而且晶体管在截止前出 \square 口大 I_{C} 峰 \square 口流,开关管 \square 耗大。适用于几十 W \square 出功率的 \square 源,目前我 \square 采用 Royer \square 路的 \square 化效率大 \square \square 75 % \sim 85 %。

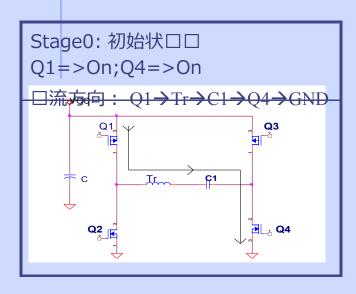
(1)全□式□路是采用 4 个开关晶体管 Q1/Q2 和 Q3/Q4 接成□路,采用 Q1/Q4 和 Q2/Q3 交替通 / 断工作,□□器初□□□上施加交流□□的方式,适用从几十 W 到几千 W 的□出功率,由于它采用了零□□切□方式,因此开关管的功率□耗很小,其□化效率大□在 80 %以上。

第一□ 全□式回路工作原理

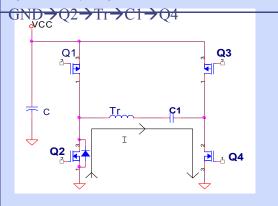
□□开关管与采用零□□切□开关晶体管的差异,如下□:

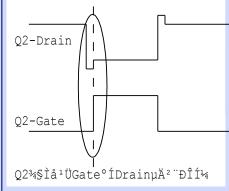


采用零电压切换后,开关晶体管自身功率损耗非常小,故全桥式电路,开关晶体管温升较低,效率较Royer回路高,适合做大功率电源。

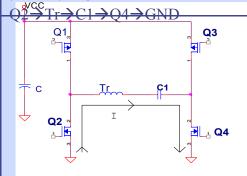


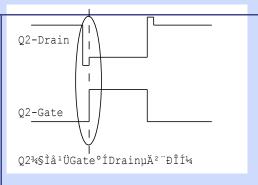
Stage1:Q1=>Off;D(Q2)=>On;Q4=>On; 当 Q1 = Off \Box ,由于 \Box 口器一次 \Box 存在自感 \Box 口,使得 \Box 口器一次 \Box 的 \Box 流不能立即中断,故当 Q1=Off \Box ,Q2 自身的二极管 D 被打开,此 \Box 口流方向:



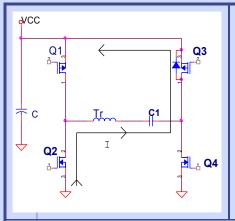


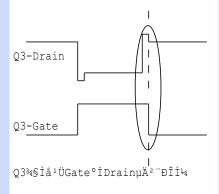
Stage2:Q2=>On;Q4=>On, 当 Q2 自身二极管被打开口,在二极管的 Source 和 Drain 之口口口大口口 $V_{DS}=-0.7V$,口口 Q2 晶体管被打开,因此, Q2 开关晶体管有零口口切口功能。此口口流方向:



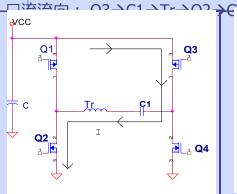


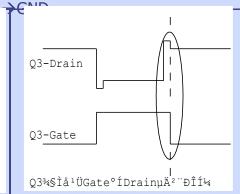
Stage3:Q2=>On;Q4=>Off;D_{Q3}=>On, 此口,由于口口器一次口的口流不能立即中断,只能打开 Q3 自身二极管口行口流,口流流向: $GND \rightarrow O2 \rightarrow Tr \rightarrow C1 \rightarrow D_{cs}$





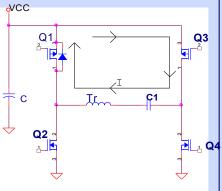
Stage4:Q3=>On;Q2=>On, 当 D_{Q3} =On, 开关晶体管 Q3 的 Source 和 Drain 之口的口口 V_{DS} =-0.7V, 口口开关晶体管 Q3 被打开,因此,晶体管 Q3 具有零口口切口功能。

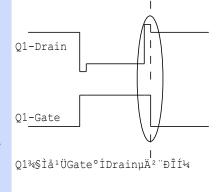




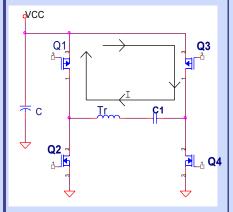
Stage5:Q2=>Off;D $_{Q1}$ =>On;Q3=>On, 当 Q2=Off \square 由于 \square 由于 \square 由于 \square 由于 \square 中断,故当 Q2=Off \square , Q1 自身的二极管 D 被打开,

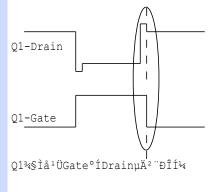
□流流向: Q3→C1→Tr→ D_n→Q3



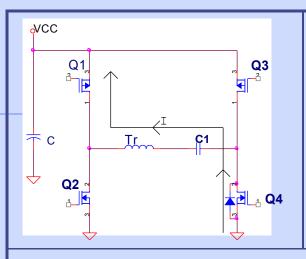


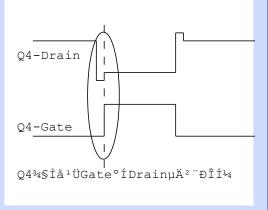
Stage6:Q1=>On;Q3=>On, 开关晶体管 Q3 的 Source 和 Drain 之口的口口 V_{DS} =-0.7V, 口口开关晶体管 Q3 被打开, 因此,晶体管 Q3 具有零口口切口功能。



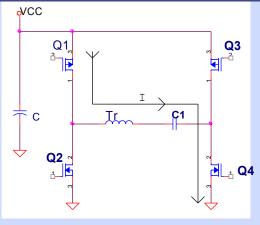


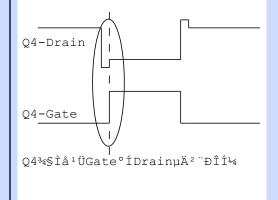
Stage7:Q1=>On;Q3=>Off;D_{Q4}=>On, 当 Q3=Off \square 由于 \square 品一次 \square 存在自感 \square \square ,使得 \square 口器一次 \square 的 \square 流不能立即中断,故当 Q2=Off \square ,Q4 自身的二极管 D 被打开, \square 流流向:GND \rightarrow D \square \rightarrow C1 \rightarrow Tr \rightarrow O1





Stage 8: 开关晶体管 Q4 的 Source 和 Drain 之口的口口 V_{DS} =-0.7V, 口口开关晶体管 Q4 被打开,因此,晶体管 Q4 具有零口口 切口功能。口流流向: $O1 \rightarrow Tr \rightarrow C1 \rightarrow Q4 \rightarrow GND$





第二□ OZ960 □用分

IC 的保□□□点:

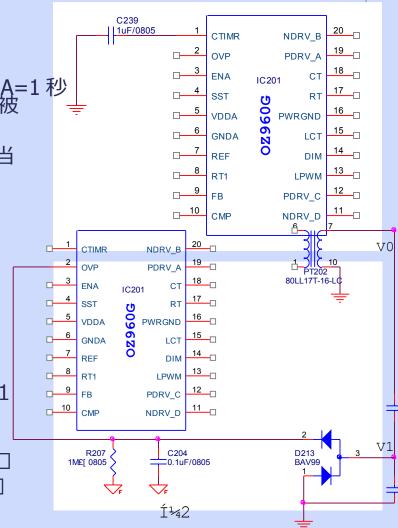
下面就来□算如下□ 2 所示□□ V0 到底多大才能使 OVP 脚到达 2V。

$$V1 = [C4/(C4+C6)]*V0$$

$$V1=V_{OVP}+V_{D}=2.0+0.7=2.7V$$

V0=[(C4+C6)/C4]*V1=[(12p+18n)/12p]*2.7=41 $00V_{p,p}$

也就是□只有□出□□的峰 – 峰□达到大于 4100 以上□, OVP □□才能到达 2V。□ 2 中 R207/C204 □峰□□□□路, 其 C204 有□□□起到平滑的作用。



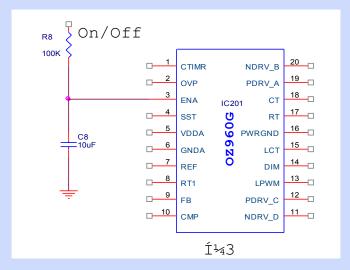
3.PIN3□ENA: IC启□□路,

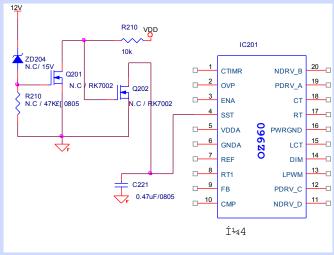
当 ENA>1.5V=>IC=On

当 ENA<0.8V = >IC=Off

如下□ 3 所示,其中 C8 的作用是□ ENA 脚慢慢地 升到 1.5V,□容 C8 充□从 0V 到 1.5V 大□需要 0.6mS

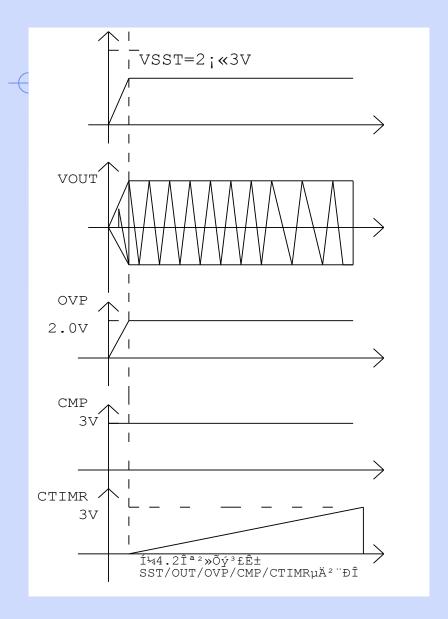
4. PIN4 □ SST: □ PIN 做□□启□,接□一个□容 C221 到地提供一个□启□功能,当 INVERTER 启□□,它提供一个 6uA 的□流□ C221 □行充□, SST 的□□不断的上升,□□ 器一次□的 Duty 也慢慢的增大,即□出□□随着 SST □□的上升而上升,当□出□□增加到启□□□□,灯管被打开,□就减少了在启□□的冲□□流,避免了□ INVERTER 零件和 CCFL 灯管在 Turn-On □不必要的□坏。如下□ 4 所示,另外 Q201 和 Q202 的作用是在□入低□□能够重新□行□启□,其原理是:当□入□□ VIN □小□, IC 停止工作,且 Q201 基极□□□得很低,此□ Q201 工作在截止区,□□ Q202 基极□□升高□ VDD, Q202 □通,

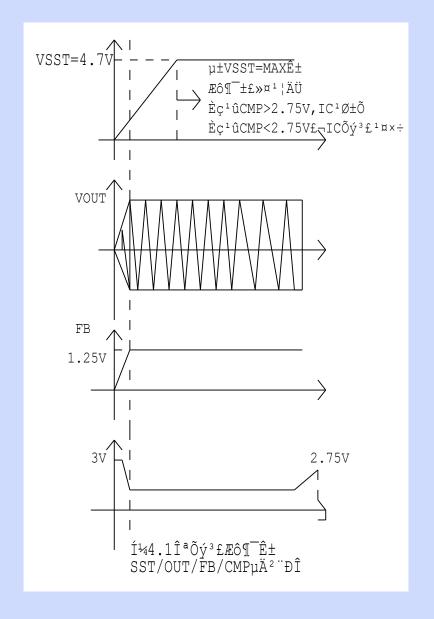




SST □位被拉低□□ 0V , 当 INVERTER □入□□□又恢复到□高如 12V □ , ZD904 □流增大,Q201 的基极□位被升高一定□□ , Q201 □通 , 接着 Q202 基极□位被拉低□低□ , Q202 又截止 , 此□ , IC 内部一个 6uA 的□流□ C221 □行充□ , 当充到一定□□ , 随着□□器□次□□□不断升高 , 升到启□□□□ , 灯管又被点亮 , 故此□路是一个重新□ 启□的回路。

在正常启口或是在灯管开路和坏掉等不正常情况来分析 SST/OUT/FB/CMP 的波形。





- 5.PIN7 □ REF: 此 PIN □出 2.5V 的基准□□, 因□□不太□定, 故通常不□到任何□路中, 只在此 PIN 串一个□容。
- 6.PIN8 □ RT1: 此 PIN 串一□阻□ INVERTER 启□□提供一个更高□率的□出□率以便□启□□□□更高。在启□□□ PIN 与 RT 和 CT 共同决定□出□□的□率。在启□□, RT1 在 IC 内部被□接到地, 此□ RT=R217//R245

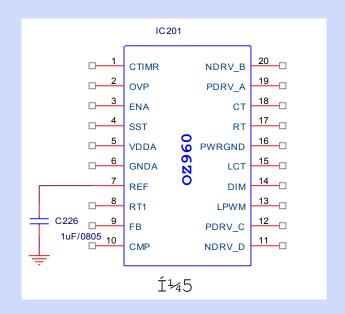
IC □出□率 F_S=(70*10⁴)/(RT[KΩ]*C220[pF])

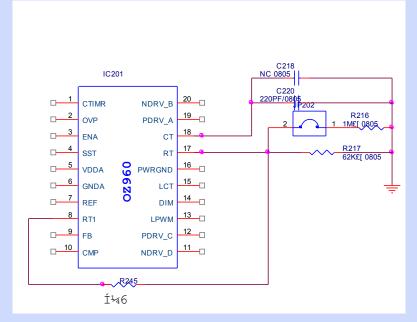
当正常工作后RT1与IC内部地断开,此口

IC □出□率 F_p=(70*10⁴)/

(R217[KΩ]*C220[pF]) 又因 \square RT<R217, 所以 $F_s > F_p$ 即后 \square □率大于工作 \square 率。

7.PIN9 □ FB; 此 PIN 接受一个半波整流平均□□,□个□□可以决定灯管□出□流通□一个 Sense □阻 R258,FB 的反□□□与IC 内部一个 1.25V 的基准□□□行比□,内部□差放大器□出脚 CMP 用来控制 Power mosfet drive 脉冲方波的移位来□整□□器一次□的 Duty,就□□灯管□流不断地被□整。以便当 DIM □定□□,能够□出一个□□定



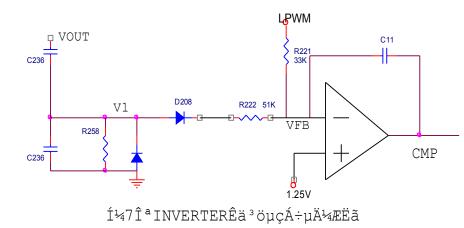


PIN10□□率□□脚,它是IC内部□差放大器的□出端通□一个□容C11(大□□560pF)与FB脚□行□接作□反□回路的□□(□□率□□□路□□是一个□分□路,□□清□大学□写的模□□子技□基□P332□),COM脚控制Power mosfet drive 脉冲方波的移位来□整灯管□流。在灯管启□□,此PIN的□□是个高□位(大于2.75V),因□在启□□没有灯管□流被□□到,□□FB是个低□位,当灯管点燃后,FB脚□位上升且CMP□位下降到正常的工作□位,在正常工作□,CMP也提供一个触□信号□灯管开路保□,如:在INVERTER工作□灯管被突然移开或是灯管坏掉,FB□位下降,且CMP上升,当CMP上升到大于2.75V□,IC被关□。

下面我□再来□算一下 INVERTER 灯管□ 流:

□ u0 □整流二极管在整流之前的瞬□表达式, Vrms=U2 □整流二极管在整流之前的有效□; 如果灯管□流最大□ Irms □ 7mA, 那么 Rsense = R258 □□取多大□ 呢?

我□从□7可以看出□□差放大器具有深度 □反□,故工作在□性区域,根据运入工作 在□性区具有虚断的特点可知



Irms*R258=U2 1.25v=0.45*7mA*R258 故 R258 = 396Ω , 通常我□会□□一个 400Ω 的 □阻

8. 如□8所示, PIN14□DIM,□PIN□控制低□PWM信号□生低□Burst-Mode方波;PIN15□LCT,□PIN外接一个□容C224到地,□生一个最低□1V,最高□3V的三角波,□PIN的□位和DIM□位□行比□来控制LPWM的占空因子且所□生的□率F=1490/C224;PIN13□LPWM,当DIM>3V□,LPWM=LOW;当DIM<1V□,LPWM=HIGH;当1V<DIM<3V□,LPWM=HIGH;当1V<DIM<3V□,LPWM□出脉冲波,如8.1□所示。

下面如 \square 8 所示,我 \square 来 \square \square 一下当 V_{DIM} 的范 \square 确定 \square ,怎 \square 来 \square \square \square \square 阳 R1/R2/R3 的阻 \square 大小。

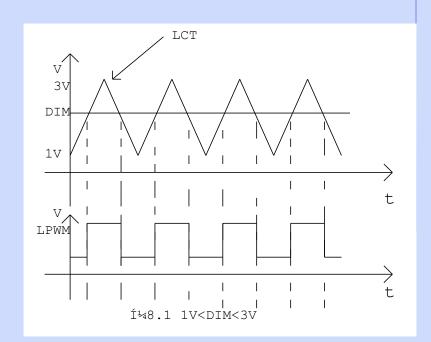
当灯管□流 I=3.5mA-8.0mA→Duty-cycle=43%-100%

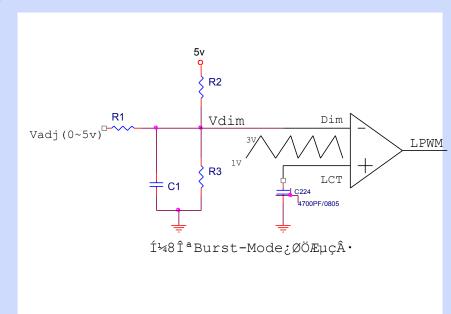
→V_{DIM}=0.9V-2.1V

如果 Vadj=0v □, □有: 0.9/R1+0.9/R3=(5-0.9)/R2

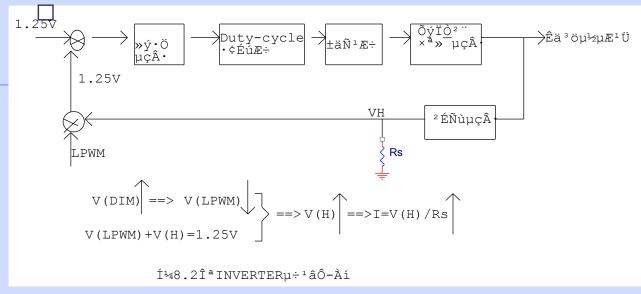
如果 Vadj=5v □, □有: (5 - 2.1)/R1+(5-2.1)/R2=2.1/R3

当我□□定 R1=270K □, 就可以算出 R2=360K,R3=111.7K, 通常会□□ R3=100K.

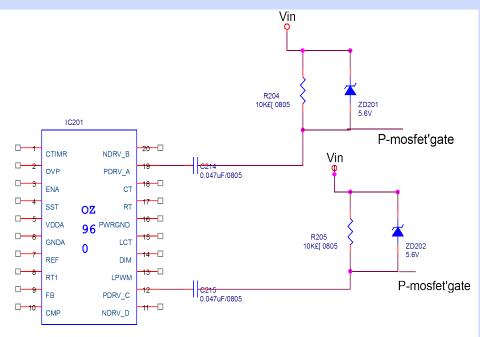


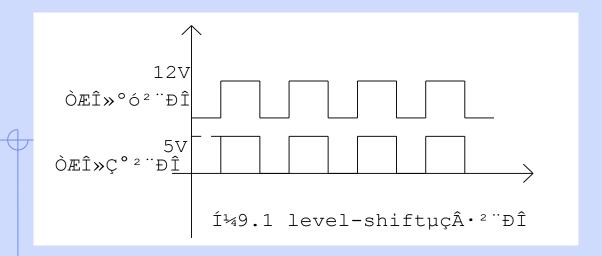


□ 8.2 □ INVERTER □光一个大概的原理



9. PIN11 和 PIN20 □ N 沟道 MOSFET □□□出; PIN12 和 PIN19 □ P 沟道 MOSFET □□□出; □ 9 是由 C214/R204/ZD201 和 C215/R205/ZD202 □成了水平 – 移位□路, 因□ PDRV_A 和 PDRV_C 的□出高□位是 5V,而 P-MOS 做开关切□□需大于 5V, 故 PDR 的□位必□被移位



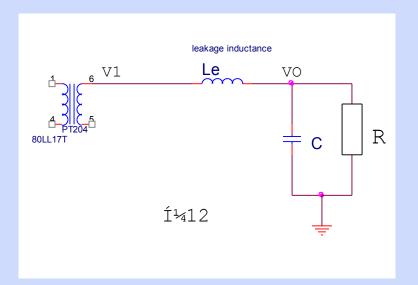


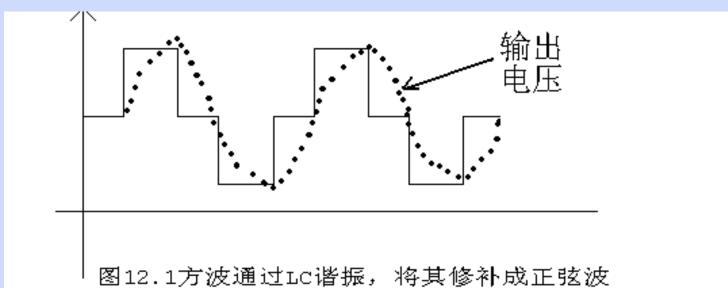
第三□ □出端□振□路

(一)□12□LC串□□振□路,此部分□路是将□□器一次□的方波都□LC□振,使□化成正弦波,此□路的□□是将方波分解出来的一次□波以后的□振波通□漏感与□容C(□容在□率很高□,相当于短路,故方波分解出来的高次□波直接通□□容C流到地)□吸收了

(任何一个方波都可用傅里叶公式

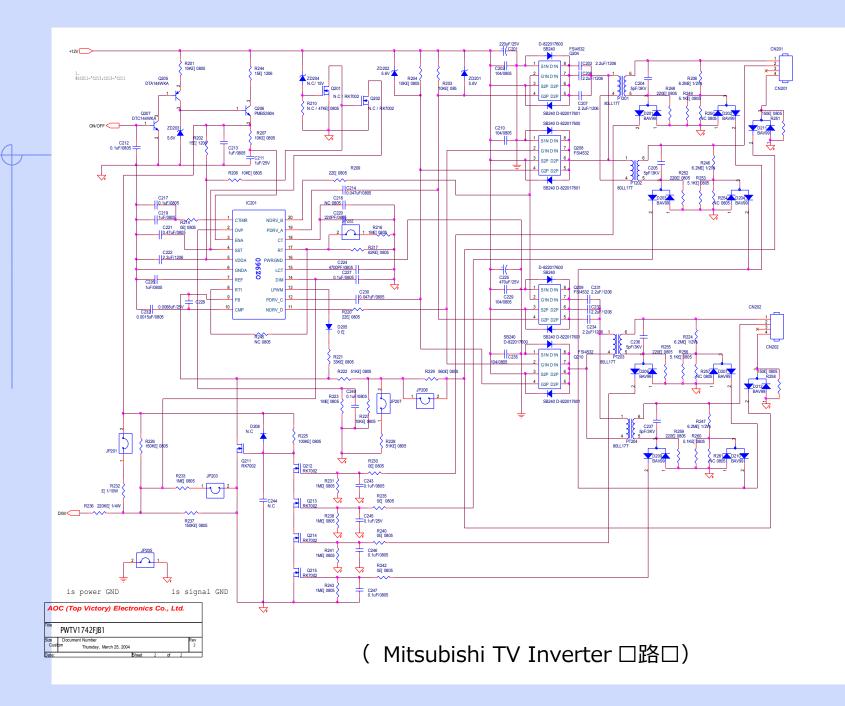
F(t)=(4Am/3.14)*(Sinwt+1/3Sin3wt+...... +1/kSinkwt) 展开,其式中 Am □方波的振幅, k □奇数,其第一□(4Am/3.14)*Sinwt □基波 ,第二□(4Am/3.14)*1/3Sin3wt □一次□波)





如: 当方波从低电平跳动高电平时,由于漏电感有抑制作用, 使输出波形慢慢上升到最大,当方波从高电平跳到低电平时, 由于漏电感有抑制作用,使输出波形慢慢下降到最小

OZ960 在 Mitsubishi TV 中的口用如下口



#